

2010年度

窒化物半導体結晶成長講演会 プログラム

14日		カテゴリー	講演者	所属	題 目	座長
13:00	13:10	Opening	平松和政・ 藤岡 洋	三重大学・ 東京大学	はじめに	三宅
13:10	14:00	基調講演	瀬戸 明伯、熊谷 義直	東京農工大学	窒化物半導体のHVPE成長 ー表面反応解析から結晶成長へー	藤岡
14:00	14:30	招待講演	山口智広、荒木努、名西やすし	立命館大学	DERI法を用いたIn系窒化物半導体の結晶成長とデバイス構造 作製への応用(日本結晶成長学会 奨励賞)	
14:30	15:00	招待講演	秩父重英、羽豆耕治、加賀谷宗 人、尾沼猛儀	東北大学	m面AlGaN混晶薄膜の発光スペクトルと構造・点欠陥の関係	
15:00	15:15	休憩				
15:15	16:00	チュートリアル 講演	長谷川文夫	筑波大学	窒化物半導体高速・パワーデバイスの基礎と最近の進展	須田
16:00	17:12	ショートプレゼン		25件	ワイドギャップ窒化物半導体	
17:12	18:27	ポスター				
18:30	20:30	意見交換会				

15日		カテゴリー	講演者	所属	題 目	座長
9:00	9:45	チュートリアル 講演	森勇介、北岡康夫、今出完、三 好直哉、吉村政志、佐々木孝友	大阪大学	Naフラックス法によるバルクGaN結晶育成技術	熊谷
9:45	10:15	招待講演	岡田成仁、大下弘康、高見成 希、栗栖彰宏、只友一行	山口大学	サファイア加工基板を用いた非極性面GaN成長とその成長機構	
10:15	10:30	休憩				
10:30	11:00	招待講演	秋山 亨、中村浩次、伊藤智徳	三重大学	窒化物半導体非極性面の表面構造への量子論的アプローチ	寒川
11:00	12:15	ショートプレゼン		24件	InGaN及びInN系	
12:15	12:34	昼食				
12:34	13:54	ポスター				
13:54	14:00	休憩				
14:00	14:45	チュートリアル 講演	西永 頌	豊橋技術科学 大学	エピタキシャル成長における不純物ドーピングのメカニズム	松本
14:45	15:15	招待講演	岩谷素顕、上山 智、天野 浩、 赤崎 勇	名城大学	非極性・半極性窒化物半導体の結晶成長技術	
15:15	15:45	招待講演	本田善央、谷川智之、村瀬輔、 光成正、山下康平、山口雅史	名古屋大学	加工Si基板上への非極性GaN選択成長	
15:45	16:00	closing				

日本結晶成長学会 ナノ構造・エピタキシャル成長分科会 幹事リスト

藤岡洋 東京大学 (担当理事)	三宅秀人 三重大学 (担当理事)
成塚重弥 名城大学 (理事)	岩谷素顕 名城大学
宇治原徹 名古屋大学	片山竜二 東京大学
寒川義裕 九州大学	熊谷義直 東京農工大学
杉山正和 東京大学	須田淳 京都大学
田中悟 九州大学	反保衆志 産業技術総合研究所
平松和政 三重大学	松本功 日酸EMC
本久順一 北海道大学	